Partial Translation of JP63-229881

- (63) Published on September 26, 1988
- (22) Filed on March 19, 1987
- (71) Applicant: Toshiba Corporation

Translation of page 2, upper left column, lines 15 - 19:

However, since semiconductor laser diodes have a temperature dependent characteristic, the same optical output level cannot be obtained without elevating a bias current when the environmental temperature rises.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-229881

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)9月26日

H 01 S 3/096 # H 04 B 9/00 7377-5F 7240-5K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

49発明の名称

バースト光出力装置

②特 顧 昭62-65272

20出 願 昭62(1987)3月19日

郊発明者 皆藤

東京都日野市旭が丘3丁目1番地の1 株式会社東芝日野

工場内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 本 田 崇

明相

1. 発明の名称

パースト光出力装置

2. 特許請求の範囲

半導体発光素子と、この半導体発光素子のパースト光出力の一部を検出する光検出素子と、前配半導体発光素子のパイアス電流の増加速度を異ならせる複数のパイアス電源と、周囲温度を検出する感温素子と、前配検出素子により得られる温度信号とに基づき前配複数のパイアス電流の選択を行ってパイアス電流を制御する選択制御手段とを具備するパースト光出力装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、半導体レーザの光出力レベルを 安定化するようにしたパースト光出力装置に関す るものである。

(従来の技術)

近年、大容量の情報を伝送する通信システム・ として、光通信システムが注目されている。この 光通信システムにおいては、正確な光パースト通 信を行うために、光信号の送信レベルを安定的に 保持することが求められる。

ところで、バースト状の光信号を、半導体レーザダイオードを用いて発光させた場合、半導体レーザダイオードの熱応答によって、その出力にサグが現われることが知られている。この熱サグは、単調減少するものであるから、従来、以下の如き制御を行い、熱サグの除去を行っていた。

半導体レーザダイオードの光出力の一部を光検 出素子でモニタし、得られる検出信号を予め設定 された基準信号と比較する。比較の結果、上配検 出信号のレベルが上記基準信号のレベルより小さ いことが検出されると、半導体レーザダイオード のバイアスレベルを増加させる一方、上配検いこ 号のレベルが上記基準信号のレベルより大きいこ とが検出されると、半導体レーザダイオードのバ イアスレベルを一定に保持するようにし、光出力

特開昭63-229881(2)

レベルを安定化するようにしていた。

実際には、第5図に示されるような半導体レーザダイオード10に、トランジスタ11をコンデンサ12で制御して、バイアス電流I₈を与える。この場合、図示せぬ光検出素子により得た半導体レーザダイオード10の光出力の一部に基づく検出信号と基準信号との比較結果の信号13で、スイッチ14を制御し、電流源15よりコンデンサ12の充電電圧V_Cをコントロールするのである。

更に、安定な光出力を迅速に得るため、バースト光出力を得る初期時に、パイアス電流の増加速度を大きくし、パイアス電流が安定化レベルに近づいたとき、パイアス電流の増加速度を小さくす。 るようにする制御方式が提案されている(第6図)。

しかしながら、半導体レーザダイオードは、温度特性を有し、第7図に示されるように、周囲温度が上昇した場合には、与えるバイアス電流を大きくしなければ、向一の光出カレベルが得られない。このため、第6図に示した従来の方式で光出力を行うと、周囲温度が変化した場合に、夫々の

を行う必要が生じ、制御が複雑で煩しいものとなる欠点があった。本発明はかかる従来のバースト 光出力装置の欠点に鑑みなされたもので、その目 的は、バースト光出力の送信レベルの安定化迄に 要する時間を、周囲温度の変化に拘わらず、一定 とすることが可能なバースト光出力装置を提供す ることである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

半導体発光素子と、この半導体発光素子のパースト光出力の一部を検出する光検出素子と前記半導体発光素子のパイアス電流の増加速度を異ならせる複数のパイアス電流と、周囲温度を検出する感温素子と、前記検出素子により得られる温度信号とに基づき前記複数のパイアス電流の選択を行ってパイアス電流を制御する選択制御手段とを具備させるようにしてパースト光出力装置を構成したものである。

(作用)

温度における安定化レベルにまでパイアス電波が 到途するに要する時間に、時間差が生じる。即ち、 第8図に示すように、周囲温度が、 T_1 と T_2 で ある場合の半導体レーザダイオードに与えるパイ アス電流が、夫々、安定化レベル1.2にあると き、半導体レーザダイオードの光信号の送信レベ ルが安定化されるとすると、安定化する迄の時間 差は ΔT_1 となる。

すると、バースト光出力の指示から、実際に安定的な送信がなされるまでの時間に、周囲温度によって、差が生じ、光通信システムにおける光信号の送受の場合、この時間差を考慮した制御を行う必要が生じ、制御が複雑で煩しいものとなる欠点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

上記のように、従来のバースト光出力装置では、周囲温度の変化による半導体レーザダイオードの光信号の送信レベルが安定化される迄に要する時間に差が生じることになった。このため、光信号の送受の場合に、この時間差を考慮した制御

上記構成によると、周囲温度と現在出力されている光信号をモニタして得た光検出信号とにより、パイアス電流の増加速度が所要となるようにパイアス電流を選択して、パイアス電流IBの増加曲線が適宜決定されるようにできるため、第4図に示すように、安定化レベル1,2までパイアス電流を上昇させる場合に、ある曲線を描くような特性のパイアス電源を選択することで、安定化までの時間 t2を一定とすることが可能である。

(実施例)

以下、図面を参照して本発明の一実施例を説明する。第1図は本発明の一実施例の構成図である。周図において、第5図と同一の構成要素には、周一の符号を付し、その説明を省略する。

この実施例では、第1の電流流15と第2の電流流16とを、夫々、スイッチ14,17で選択して、パイアス電流 I_B の増加速度が変化するように制御する。30は切換部を示し、この切換部30は、パイアス制御信号41と、第2図に示される感温素子(サーミスタ等)33による信号とにより、駆動信

身31. 32を作り、スイッチ14. 17を開閉して、コ ンデンサ12を充電する充電電流IC に温度特性を 持たせる。18は光検出素子たるフォートダイオー ドであり、フォートダイオード18は、半導体レー ザダイオード10より出力された光出力の一部を検 出して、バイアス制御信号41に変換する。切換部 30は、第2図に示されるような電流源34を含む差 動増幅器の構成でトランジスタT。1.T。2の コレクタ電圧を駆動信号31、32としている。トラ ンジスタT。1のベースには、入力端子INより バイアス制御信号41が与えられる。また、トラン ジスタT 2のベースには、感温素子33と抵抗 R4 とで決定される電圧が与えられ、トランジス タT 2は、初期状態においてオン状態にある。 スイッチ14は、駆動信身31が、Hレベルのとき閉 じられ、Lレベルのとき聞かれ、スイッチ17は、 駆動信号32が、Hレベルのとき開かれ、Lレベル のとき閉じられる。このような、切換部30と、ス イッチ14.17は、選択制御手段50を構成する。尚、 本実施例では、パイアスを与える期間を制御する

構成、パースト信号を与える構成を図示していないが、例えば、前者の構成は、フォートダイオード18と選択制御手段50との間に、後者の構成は、トランジスタ11と選択制御手段50との間に、夫々、介押される。

以上のように構成された、実施例の動作を、第1図乃至第3図を参照して説明する。バイアス印加の期間となると、切換部30の入力増子【Nには、未だ半導体レーザダイオード10の発光が生じいないため、電圧はほとんど与えられていたうとで、トランジスタTr 1はオンの状態とないたある。この結果、スイッチ14,17ともに開成された状態で、第1日によるで、第2の電流源15、16による充電電流で、第1日の増加速度でバイアス電流が増加する。この電圧により、コ関係号のレベルが増加する。この電圧により、1回りでは、10円を表して、半導体レーザダイオード10の発光が開始され、フォトダイオード18によるバイアス制御信号のレベルが増加する。この電圧により、1回りでは、1回りでは10円を表して、1回りでは10円を表して、1回りでは10円を表して、1回りでは10円を表して、1回りでは10円を表して、10

ここで、感温素子33は、周囲温度が低い T_1 の場合には、第3図の時間 t_1 でトランジスタ T_1 1がオンとなるように、また、周囲温度が高い T_2 の場合には、第3図の時間 t_1 + $\Delta \tau_2$ でトランジスタ T_1 1がオンとなるように、トランジ

スタT_P 2のベースへ管圧を与える。そして、トランジスタT_P 1がオンとなった後は、トランジスタT_P 2のエミッタ電圧が、感温素子33によって決められているベース電圧に対し、所定差となるまで、コンデンサCに対する充電がなされ、いずれの温度にあっても、時間t₂で安定に達する。

尚、本実施例では、電流液を2個としたが、3個以上であっても良い。このようにすると、より橋かく制御が可能となる。また、第2図の切換部30の回路定数を調整することにより、ボイアス電流の増加速度及び、増加速度の切換点を変更でき、安定化するまでの時間 t 2 をや箱可能となる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば、周囲 温度と現在出力されている光信号をモニタして特 た光検出信号とにより、パイアス電源の増加速度 が所要となるようにパイアス電源を選択して、パ

特開昭63-229881(4)

イアス電流の増加曲線が適宜決定されるようにでき、安定化までの時間 t を一定とすることが可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の構成図、第2図は第1図の要部の構成図、第3図は第1図の一実施例の動作を説明するための波形図、第4図は本発明の原理を説明するための波形図、第5図は従来のバースト光出力装置の構成図、第6図、第8図は従来のバースト光出力装置の動作を説明するための波形図、第7図は半導体レーザダイオードの温度特性を示す図である。

10…半導体レーザダイオード。

14, 17…スイッチ。 15…第1の電流源

16…第2の意流源。 18…フォートダイオード

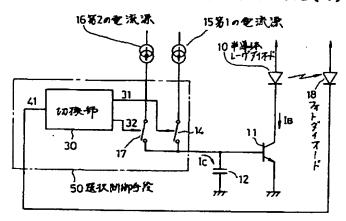
30---切換部。

31. 32…駆動信号

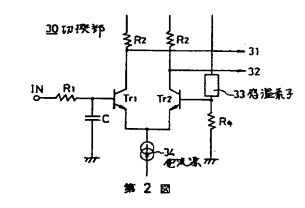
34…電流源

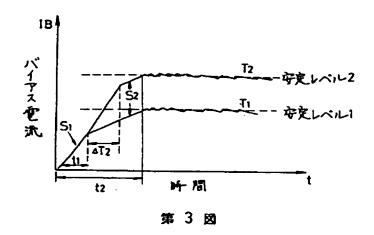
33…感温素子。 50…選択制御手段

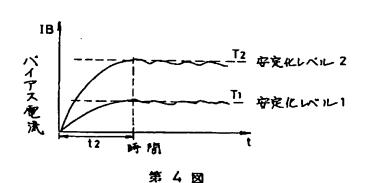
代理人 弁理士 本 田 崇

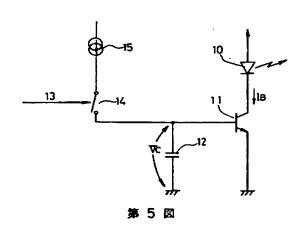


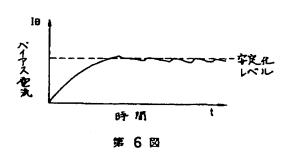
第 1 図

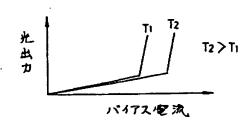




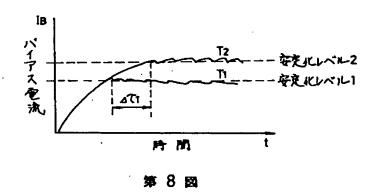








第 7 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LÌNES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.